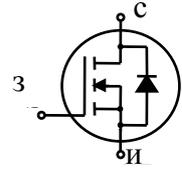
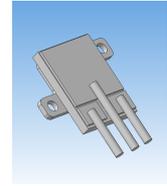




## Мощный высоковольтный МДП транзистор



Стойкость к воздействию  
спец. факторов- 2Ус



Корпус

КТ-105-1

### Максимальные параметры

Обознач.	Наименование параметра	Значение	Ед. изм.
Uси макс	Макс. напряжение сток-исток	1200	В
Uзи макс	Макс. напряжение затвор-исток	±25	В
Iс макс	Макс. ток стока	10	А
Iс и макс	Макс. импульсный ток стока	30	А
Rмакс	Макс. допуст. пост. мощность	200	Вт
Tпер макс	Макс. допуст. температура перех.	150	°С
Tраб corp	Рабочая температура корпуса	- 60 до 125	°С

### Электрические характеристики при Tпер = 25 °С

Обозн.	Название параметра	Значение параметра			Един. измер.	Режим измерения
		Не менее	Тип.	Не более		
Iс нач	Начальный ток стока			1,5	мА	Uси = 1200 В, Uзи = 0 В
Iз ут	Ток утечки затвора			100	нА	Uзи = ±20 В
Rси отк	Сопротивление сток-исток в откр. состоянии		0,9	1	Ом	Uзи = 15 В, Iс = 5 А
Uпор	Пороговое напряжение	2,0		4,0	В	Uзи = Uси = 10 В, Iс = 10 мА
S	Крутизна		11			Uси ≥ 15 В, Iс = 5 А
Qз			192		нКл	Uси = 600 В, Iс = 5 А
Qзи			48		нКл	Uзи = 13 В
Qзс			68		нКл	
tз вкл			64		нс	Uси = 600 В, Iс = 5 А,
tнар			12		нс	Uзи = 10 В, Rз = 2 Ом
tз выкл			184		нс	
tсп			40		нс	
Rз	Вход. сопротив. затвора		1,2		Ом	
Cвх	Входная емкость		7000		пФ	Uси = 25В, Uзи = 0 В
Cвых	Выходная емкость		500		пФ	f = 1МГц
Cпрох	Проходная емкость		100		пФ	

### Электрические параметры встроенного диода

Обозн.	Название параметра	Значение параметра			Един. измер.	Режим измерения
		Не менее	Тип.	Не более		
Iд	Прям. ток диода		10		А	
Uпр д	Прям. напряжение диода		0,8		В	Iс = 5 А
tобр вос			240		нс	dI/dt = 1А/мкс, Iд = 1А
Qобр вос			0,138		мКл	dI/dt = 1А/мкс, Iд = 1А

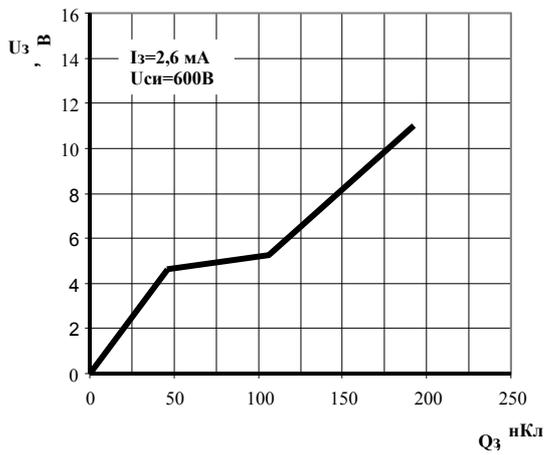


Рисунок 1 – Зависимость заряда затвора  $Q_3$  от напряжения затвора  $U_3$  для транзистора типа 2П829А

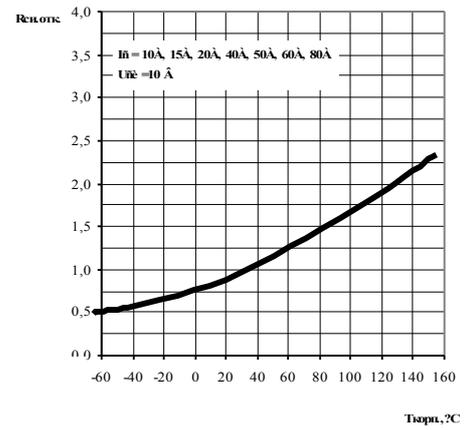


Рисунок 4 - состояние  $R_{си.отк.}$  от температуры корпуса  $T_{кorp.}$  транзисторов 2П829А

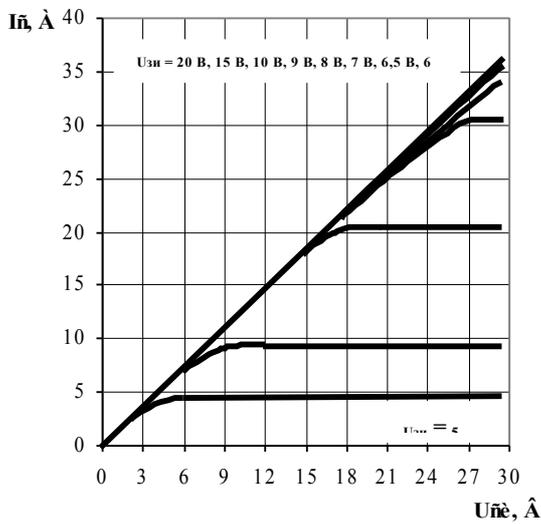


Рисунок 2 – Зависимость тока стока  $I_c$  от напряжения сток-исток  $U_{си}$  транзисторов 2П829А

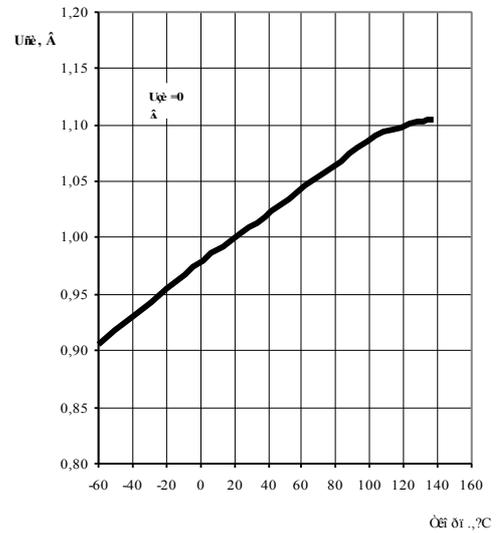


Рисунок 5 - Зависимость нормализованного напряжения сток-исток  $U_{си}$  от температуры корпуса  $T_{кorp.}$  транзисторов 2П829А

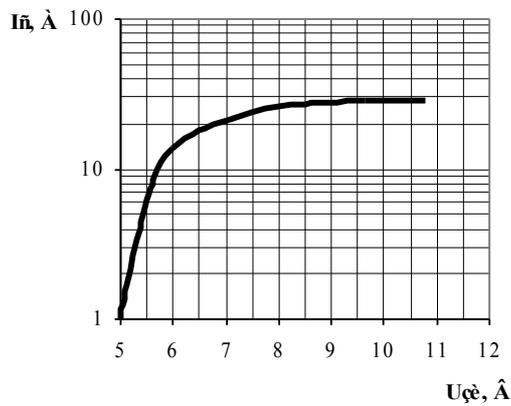


Рисунок 3 - Зависимость тока стока  $I_c$  от напряжения затвор-исток  $U_{зи}$  транзисторов 2П829А

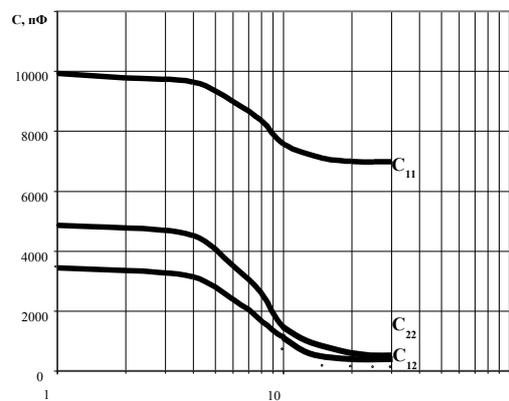


Рисунок 6 – Зависимости входной ( $C_{11}$ ), выходной ( $C_{22}$ ) и проходной ( $C_{12}$ ) емкостей от напряжения сток-исток при температуре корпуса  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$  транзисторов 2П829А

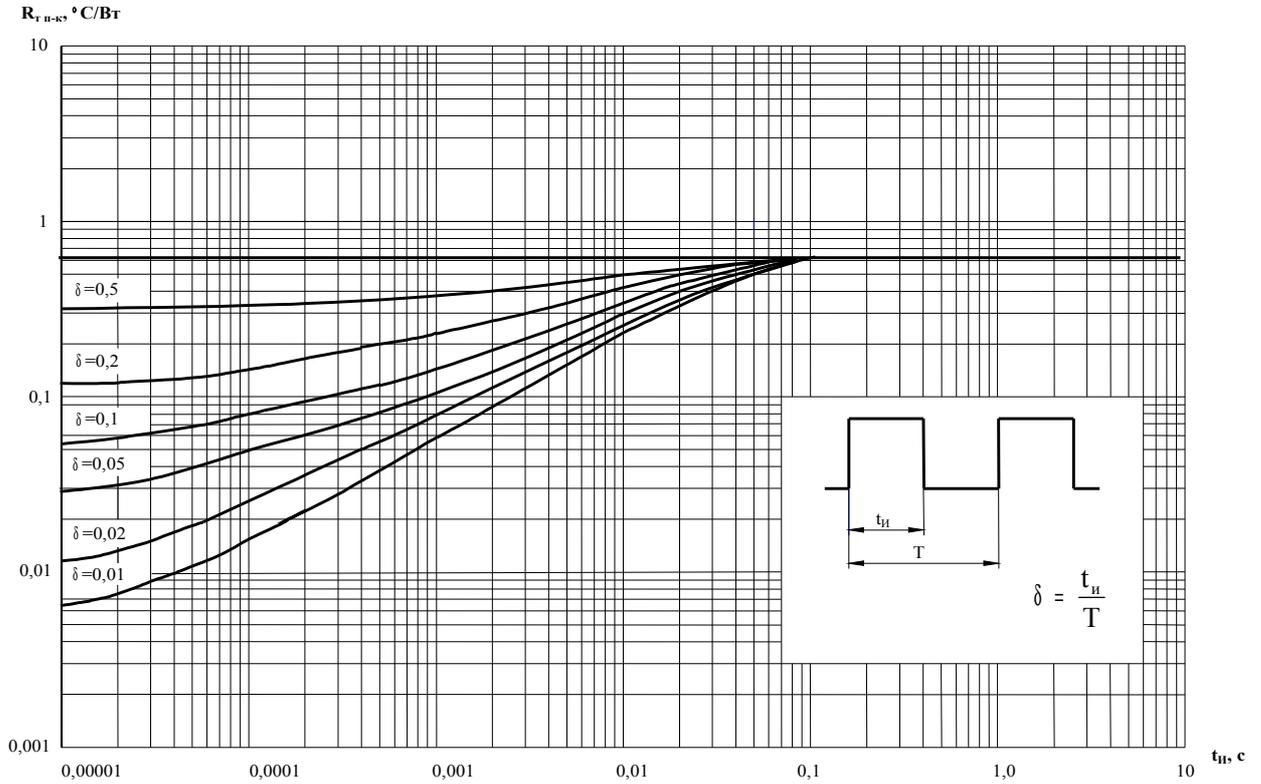
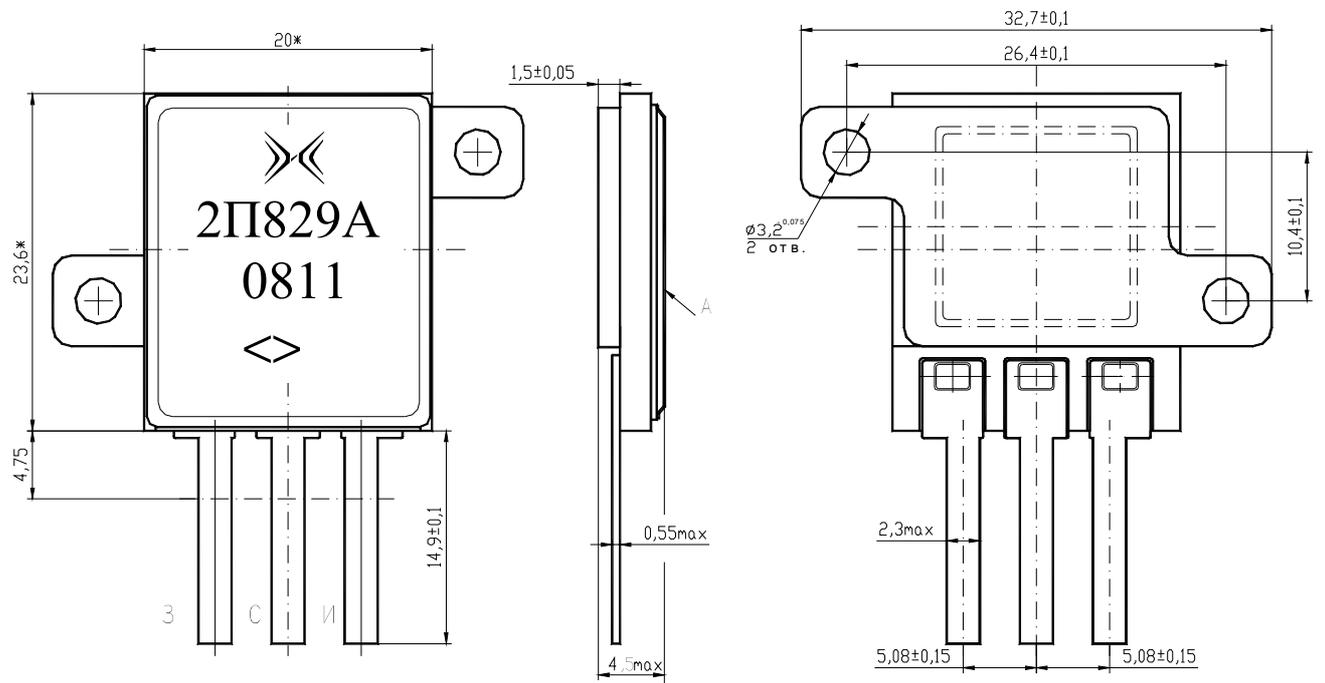


Рисунок 7– Зависимость теплового сопротивления переход-корпус  $R_{ТП-К}$  от длительности импульса  $t_{и}$  и скважности импульса  $\delta$  транзисторов 2П829А,

### Габариты корпуса КТ-105-1



Обозначение выводов	Назначение выводов
1	Сток
2	Исток
3	Затвор

